
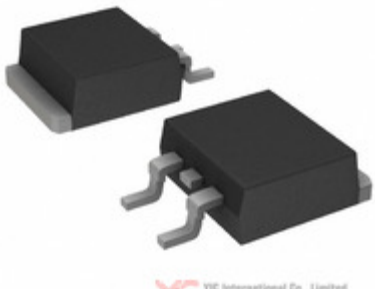

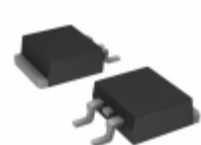
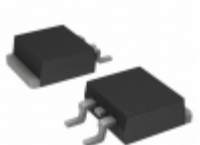
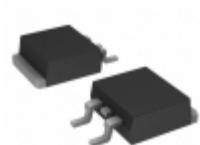




	<p>FDB12N50UTM_WS</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB12N50UTM_WS</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 10A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB12N50UTM_WS.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB12N50UTM_WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 10A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	FRFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	165W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB12N50UTM_WSCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1395pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 10A (Tc) 165W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

FDB12N50UTM_WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB12N50UTM_WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB12N50UTM_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB12N50UTM_WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB12N50U F FDB12N50U F</p>	 <p>FDB13AN06AO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-263AB</p>	 <p>FDB12N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A D2PAK</p>	 <p>FDB13AN06AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-263AB</p>
 <p>FDB13AN06AO FAIRCHILD FDB13AN06AO FAIRCHILD</p>	 <p>FDB13AN06A FAIRCHILD FDB13AN06A FAIRCHILD</p>	 <p>FDB12P10 VB FDB12P10 VB</p>	 <p>FDB12N50UTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 10A D2PAK</p>

FDB12N50UTM_WS Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB12N50UTM_WS Datenblatt	FDB12N50UTM_WS-Datenblätter	FDB12N50UTM_WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB12N50UTM_WS
FDB12N50UTM_WS Electronic	FDB12N50UTM_WS-Komponenten	FDB12N50UTM_WS-Bild	FDB12N50UTM_WS-Teil
FDB12N50UTM_WS Preis	FDB12N50UTM_WS Hersteller	FDB12N50UTM_WS Aktie	FDB12N50UTM_WS Inventar
FDB12N50UTM_WS Neu	FDB12N50UTM_WS Original	FDB12N50UTM_WS RFQ	FDB12N50UTM_WS Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited